

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第3区分

【発行日】平成23年3月17日(2011.3.17)

【公開番号】特開2008-262547(P2008-262547A)

【公開日】平成20年10月30日(2008.10.30)

【年通号数】公開・登録公報2008-043

【出願番号】特願2008-62133(P2008-62133)

【国際特許分類】

G 0 6 K	19/077	(2006.01)
H 0 1 L	27/06	(2006.01)
H 0 1 L	21/8234	(2006.01)
H 0 1 L	29/786	(2006.01)
H 0 1 L	21/336	(2006.01)
H 0 1 L	27/08	(2006.01)
H 0 1 L	27/088	(2006.01)
H 0 1 L	27/10	(2006.01)
H 0 1 L	27/115	(2006.01)
H 0 1 L	21/8247	(2006.01)
H 0 1 L	29/792	(2006.01)
H 0 1 L	29/788	(2006.01)
H 0 1 L	21/02	(2006.01)
H 0 1 L	27/12	(2006.01)
H 0 1 L	23/28	(2006.01)

【F I】

G 0 6 K	19/00	K
H 0 1 L	27/06	1 0 2 A
H 0 1 L	29/78	6 1 9 A
H 0 1 L	29/78	6 2 7 D
H 0 1 L	27/08	3 3 1 E
H 0 1 L	27/08	1 0 2 D
H 0 1 L	27/10	4 6 1
H 0 1 L	27/10	4 3 4
H 0 1 L	29/78	3 7 1
H 0 1 L	27/12	B
H 0 1 L	23/28	Z

【手続補正書】

【提出日】平成23年1月31日(2011.1.31)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】半導体装置

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

単結晶半導体基板またはS O I基板を用いて形成された半導体素子を有する基板を有し

前記基板の片面または両面に、表面処理が施された糸束の纖維体に有機樹脂が含浸された構造体が設けられていることを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】

請求項 1において、前記構造体を介して前記基板に保護フィルムが設けられていることを特徴とする半導体装置。

【請求項 3】

請求項 2において、前記保護フィルムは、ポリビニルアルコール系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリエチレン系樹脂、アラミド系樹脂、ポリパラフェニレンベンゾビスオキサゾール樹脂、またはガラス樹脂で形成されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項 4】

請求項 1乃至 3のいずれか一項において、前記纖維体は、ポリビニルアルコール系纖維、ポリエステル系纖維、ポリアミド系纖維、ポリエチレン系纖維、アラミド系纖維、ポリパラフェニレンベンゾビスオキサゾール纖維、ガラス纖維、または炭素纖維で形成されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項 5】

請求項 1乃至 4のいずれか一において、前記有機樹脂は、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ポリイミド樹脂、ビスマレイミドトリアジン樹脂、またはシアネット樹脂であることを特徴とする半導体装置。

【請求項 6】

請求項 1乃至 4のいずれか一において、前記有機樹脂は、ポリフェニレンオキシド樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、またはフッ素樹脂であることを特徴とする半導体装置。

【請求項 7】

請求項 1乃至 6のいずれか一において、前記基板と前記構造体との間に、前記半導体素子に電気的に接続するアンテナが設けられていることを特徴とする半導体装置。

【請求項 8】

請求項 1乃至 6のいずれか一において、前記半導体素子は、M O Sトランジスタ、不揮発性記憶素子、またはダイオードの一つ以上であることを特徴とする半導体装置。